

中华人民共和国第四机械工业部

部 标 准

PNP硅平面高频小功率三极管

SJ 1468~1486—79

北 京

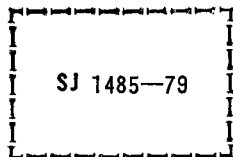
1 9 8 0

目 录

SJ 1468—79	3CG 100 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(1)
SJ 1469—79	3CG 101 型 PNP 硅平面高频小功率三极管	(4)
SJ 1470—79	3CG 102 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(7)
SJ 1471—79	3CG 103 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(10)
SJ 1472—79	3CG 110 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(13)
SJ 1473—79	3CG 111 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(16)
SJ 1474—79	3CG 112 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(19)
SJ 1475—79	3CG 113 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(22)
SJ 1476—79	3CG 114 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(25)
SJ 1477—79	3CG 120 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(28)
SJ 1478—79	3CG 121 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(31)
SJ 1479—79	3CG 122 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(34)
SJ 1480—79	3CG 130 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(37)
SJ 1481—79	3CG 131 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(40)
SJ 1482—79	3CG 132 型 PNP 硅外延平面高频小功率三极管	(43)
SJ 1483—79	3CG 140 型 PNP 硅外延平面高频小功率低噪声三极管	(46)
SJ 1484—79	3CG 160 型 PNP 硅外延平面高频小功率高反压三极管	(49)
SJ 1485—79	3CG 170 型 PNP 硅外延平面高频小功率高反压三极管	(52)
SJ 1486—79	3CG 180 型 PNP 硅外延平面高频小功率高反压三极管	(55)
附录一：符号及其意义		(58)
附录二：新旧型号对照表		(59)
附录三：光刻版图尺寸		(60)

中华人民共和国第四机械工业部

部 标 准



3CG170 型 PNP 硅外延平面高频
小功率高反压三极管

1. 本标准适用于 3CG170 型 PNP 硅外延平面高频小功率高反压半导体三极管。该产品用于电子设备中作开关及高频放大与振荡用。

2. 该产品除本标准规定外，三类应符合 SJ 281-76《三类半导体二、三极管总技术条件》的规定，二类应符合 SJ 614-73《半导体三极管总技术条件》的规定。

3. 外型结构和尺寸应符合 SJ 139-78《半导体三极管外形尺寸》的 B-4 型。

4. 技术要求和试验方法：

(1) 电参数应符合参数规范表的规定。电参数的测试方法，应符合 SJ 155~SJ 170-65《半导体三极管测试方法》的规定。

(2) h_{FE} 不分档。

(3) 环境试验后，按顺序测量下列电参数，a、b、d 三项应符合参数规范表的规范值， h_{FE} 的相对变化不得超过 $\pm 20\%$ 。

a. 反向电流；

b. 饱和压降；

c. 电流放大系数；

d. 反向击穿电压。

(4) 高温贮存和额定功率试验条件：

a. 高温贮存试验条件：按 T_{iM} 为 175°C 下进行。

b. 额定功率试验条件：功率为 P_{CM} 值，电压 V_{CB} 为 30V 。

(5) 高温贮存和额定功率试验后，按下列标准考核：

a. I_{CBO} 不得大于规范值的两倍；

b. h_{FE} 的相对变化，不得超过 $\pm 35\%$ ；

c. V_{BES} 的相对变化，不得超过 $+20\%$ ；